

王圩院士生平



中国共产党优秀党员、中国科学院院士，中国科学院半导体研究所研究员、我国著名的半导体光电子学专家王圩先生因病医治无效，不幸于2023年1月26日18点11分在北京逝世，享年86岁。半导体研究所和半导体光电子学科领域为失去这样一位学科泰斗，扼腕痛惜；家人亲朋，为失去这样一位挚爱亲人，无限悲痛；学生弟子，为失去这样一位良师益友，深切哀悼。

王圩院士是我国著名的半导体光电子学专家，1937年12月25日生于河北文安，1960年毕业于北京大学物理系半导体专业，同年到中国科学院半导体研究所工作至今。王圩院士为我国半导体学科建设、技术创新、产业振兴以及人才培养做出了重要贡献。先后获得国家“六五”攻关奖、中国科学院科学技术进步一等奖、国家科学技术进步二等奖、中国材料研究学会科学技术一等奖等。发表学术论文百余篇。1997年当选中国科学院院士。

王圩院士是我国半导体激光器的开拓者，在半导体光电子领域辛勤耕耘、造诣颇深，并取得了一系列重要科研成果。20世纪60年代率先在国内研制成功无位错硅单晶，为我国硅平面型晶体管和集成电路的发展做出了贡献。70年代率先在国内研制成功单异质结室温脉

冲大功率激光器和面发射高亮度发光管，并成功应用于夜视、引信、打靶和精密测距仪上；参与建立了国内首批III-V族化合物液相外延方法，为国内首次研制成功GaAs基短波长脉冲激光器奠定基础。80年代至90年代采用大过冷度技术和量子剪裁生长技术，研制出1.3微米/1.5微米激光器和应变量子阱动态单模分布反馈激光器，为我国提供了用于研发第二、第三代长途大容量光纤通信急需的光源。进入新世纪以来，在半导体光电子材料和器件的前端研究领域，主持开展大应变量子阱材料以及不同带隙量子阱材料的单片集成等关键技术的研究，建立了可集成半导体激光器、电吸收调制器、光放大器、探测器以及耦合器等部件的集成技术平台，为开展多个光学部件的单片集成技术奠定了基础，成为我国开展InP基功能集成材料及器件研究、技术辐射和应用的基地。

王圩院士甘为人梯、提携后进，在教育战线上辛勤耕耘60余年，倾注了大量心血和汗水，培养和造就了一大批优秀科技人才，对我国光电子学事业的发展和光电子学领域人才的培养作出了重要贡献。他严谨求实、奋斗不止的科学精神和爱国奉献、淡泊名利的高尚品德，更是广大科技工作者和师生学习的榜样。

王圩院士的一生，是无私奉献的一生，是光荣伟大的一生，他对国家和人民无限忠诚，将毕生精力奉献给了我国科技与教育事业。他富有远见卓识和开创精神，以国家的重大需求为目标，为我国的半导体事业作出重大贡献。他严于律己，克己奉公，治学严谨，为人谦和。他的业绩和品德，为中国科技事业树立了一座不朽的丰碑，他崇高的科学精神和道德风范永远值得我们学习和敬仰！

王圩院士的逝世不仅是半导体研究所的重大损失，也是我国科学界、教育界的重大损失。对王圩院士的逝世，我们表示深切的哀悼！

王圩院士千古！

王圩院士治丧委员会

2023年1月26日